

VM (주)

Investor Relations

11. 2025



Disclaimer

본 자료는 기관투자자 및 일반투자자를 대상으로, VM 주식회사(이하 “회사”)의 사업 및 재무 등 경영상황에 대한 이해를 돕기 위한 목적으로 작성된 것으로, 회사의 홍보 또는 주식·증권의 매수·매도를 권유하기 위한 자료가 아닙니다.

본 자료에 포함된 회사의 경영실적 및 재무성과 관련 정보는 일반적으로 인정된 기업회계기준에 따라 작성된 것입니다. 또한 본 자료에는 회사의 향후 경영현황 및 재무실적과 관련된 “예측정보”가 포함되어 있을 수 있습니다. 예측정보란 과거가 아닌 미래의 사건 및 전망과 관련된 정보를 의미하며, ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘(E)’ 등의 표현을 포함합니다. 이러한 예측정보는 개별적인 검증 절차를 거치지 않은 것으로, 거시경제 여건·산업 환경·경영전략의 변경 등 다양한 변수에 따라 실제 결과는 예측정보와 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 모든 전망은 작성일 현재 이용 가능한 정보와 시장상황, 회사의 경영방향을 기준으로 한 것이며, 향후 환경 변화 및 회사의 판단에 따라 별도의 고지 없이 변경될 수 있습니다.

본 자료는 투자 판단을 위한 참고자료일 뿐이며, 어떠한 경우에도 회사의 주식 또는 기타 유가증권의 모집, 매출, 매매 및 청약을 위한 법적·사실상의 제안이나 권유를 구성하지 않습니다. 또한 본 자료의 그 어느 부분도 관련 계약 체결이나 투자 결정을 위한 기초 또는 근거로 사용될 수 없습니다.

본 자료의 이용 또는 이에 기초한 투자행위로부터 직·간접적으로 발생하는 어떠한 손실에 대하여도 회사 및 회사의 이사, 임직원은 과실 유무를 불문하고 그 책임을 부담하지 않습니다. 모든 투자 결정은 투자자 본인의 책임과 판단에 따라 이루어져야 합니다.

본 자료는 투자자에 대한 정보 제공을 위한 비영리적·내부적 참고용으로만 사용될 수 있으며, 회사의 사전 서면 동의 없이 본 자료의 전부 또는 일부를 임의로 수정·가공하거나 복사·배포·전재하는 행위는 금지됩니다.

CONTENTS

VM Investor Relations 2025

01 회사소개

02 Our Business

03 PEER 비교

04 Our Strategy

- Appendix

회사 개요

회사명	브이엠 주식회사(VM, Inc)
대표자	최우형 / 임종필
설립일	2002-02-22
본사 소재지	경기도 이천시 마장면 서이천로 58-47
임직원 / 특허 수 ^(*)	108명 / 72개 (해외 28개 포함)
매출액 / 영업이익 ^(*)	936억 / 153억

(*) 2025년 9월말 현재

대표이사 약력

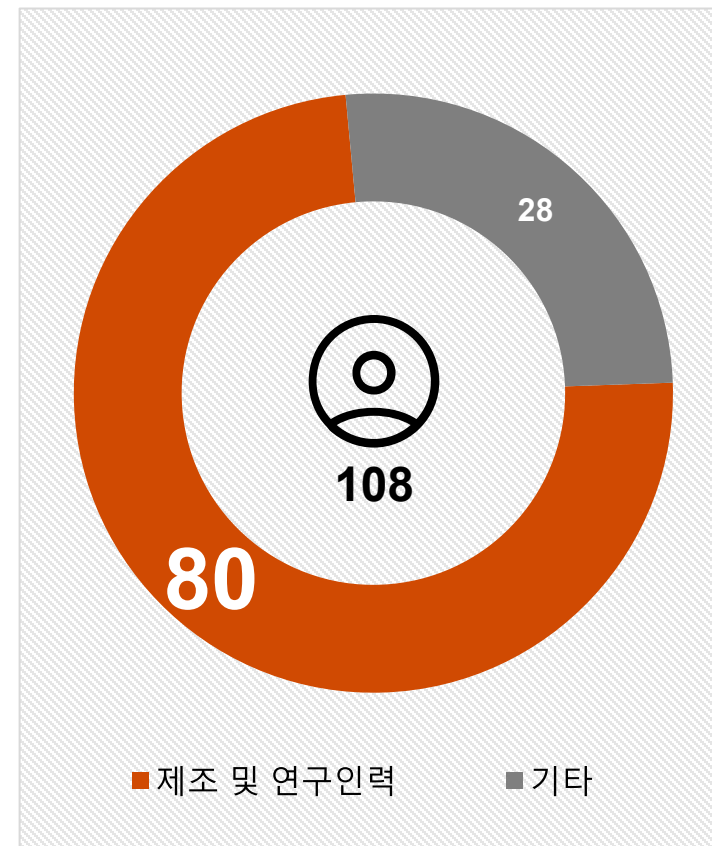
최우형

- 現 VM(주) 대표이사 ('18.11 ~)
- KoFc-KB 청년창업펀드 매니저
- KB인베스트먼트 투자담당 이사
- 고려대학교 경영학과

임종필

- 現 VM(주) 대표이사 ('24.04 ~)
- Essencore Co. 대표이사, 사장
- SK SUPEX추구협의회,
공유 Infra T/F팀장
- SK하이닉스 구매본부장

핵심 인력 구성 비율

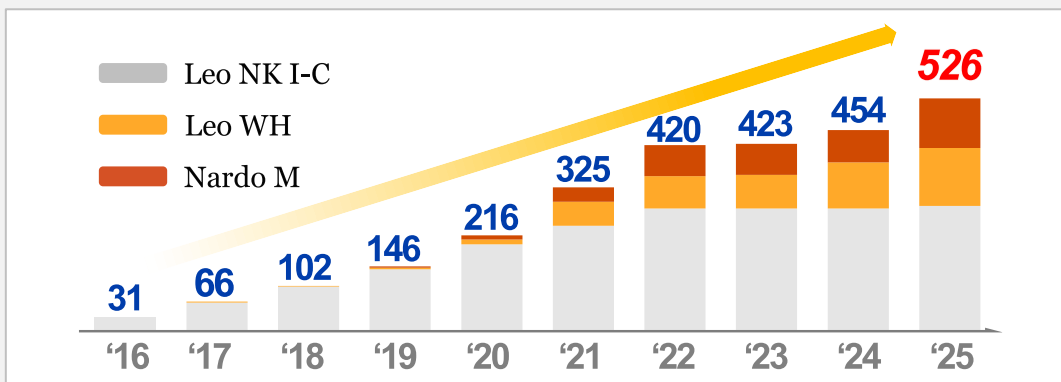


(*) 2025년 11월말 현재



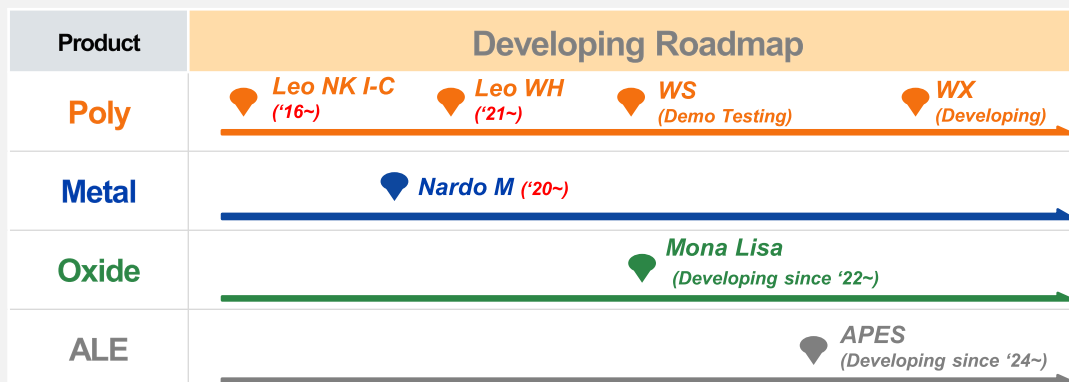
누적 챔버 공급 현황

누적 500EA 이상 챔버 판매 기록 중



납품 장비 및 개발 로드맵

Poly & Metal 양산 판매 중 (Oxide & ALE 개발 중)



최근 3개년 재무현황

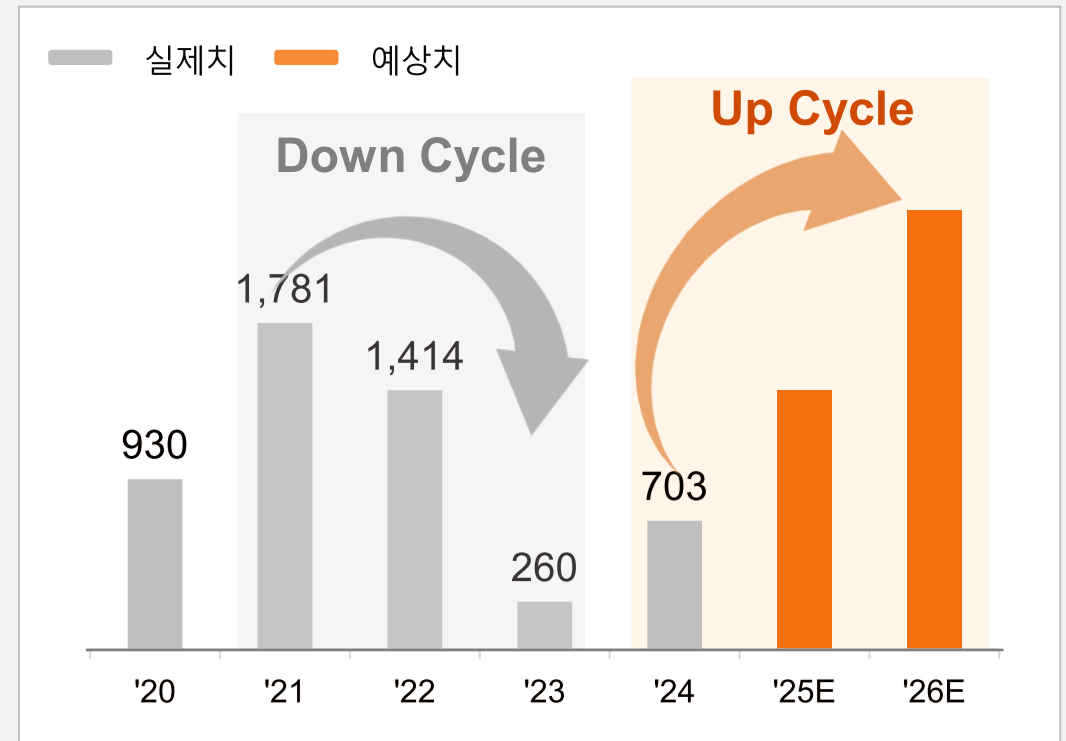
(단위: 억원)

구분	'21.12	'22.12	'23.12	'24.12	'25.09
순자산 총계	1,141	1,179	1,222	1,243	1,614
매출액	1,781	1,414	260	703	936
-제품	1,650	1,198	98	548	695
-상품	131	216	162	155	241
영업이익(손실)	540	309	(110)	(86)	153
당기순이익(손실)	465	279	(70)	(35)	150

연결 재무제표 기준

매출 성장 추이

(단위: 억원)



연결 재무제표 기준



CONTENTS

VM Investor Relations 2025

01 회사 소개

02 Our Business

03 Our Strength

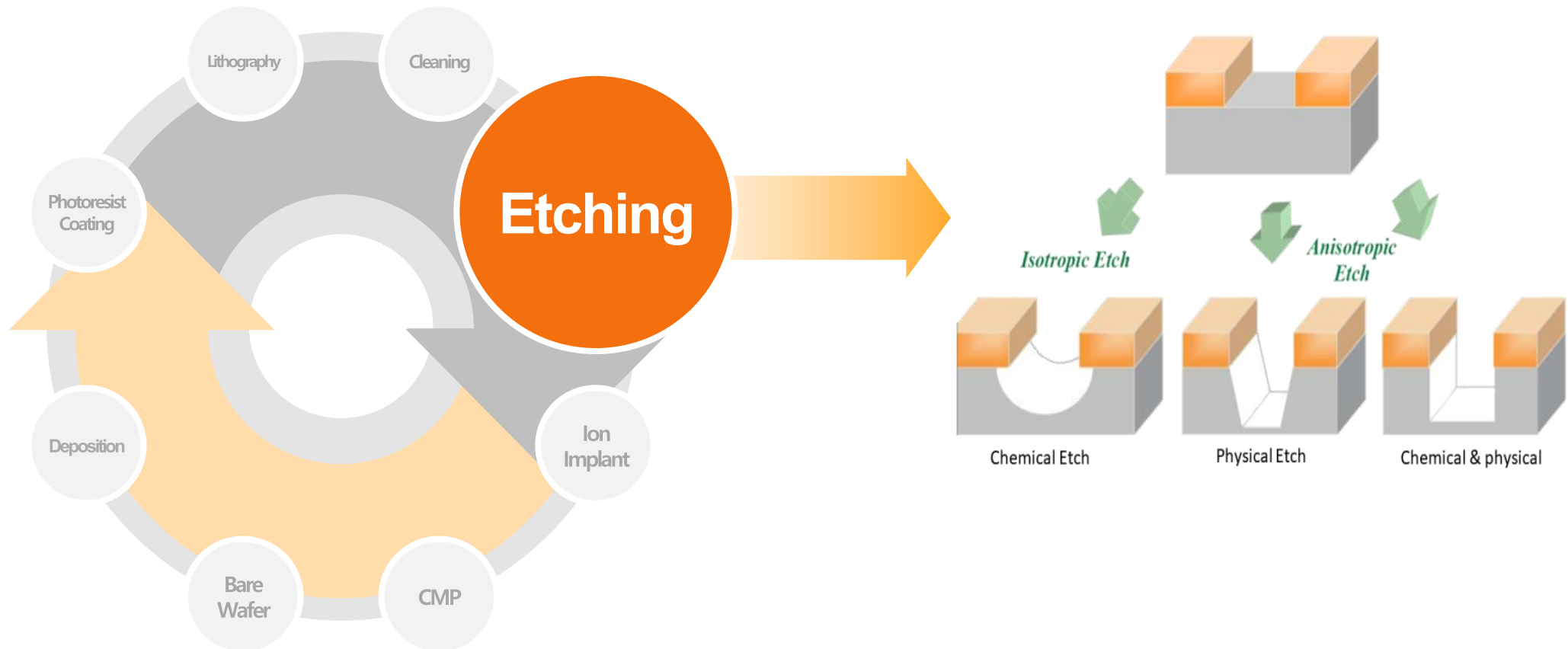
04 Our Strategy

- Appendix

식각 (Etching) 공정이란?

노광 공정 이후 진행되는 핵심 전공정 단계로, 웨이퍼에 새겨진 회로 패턴을 따라 필요 없는 **박막 부분을 깎아내어** 회로를 실제로 형성하는 공정

※반도체 전공정



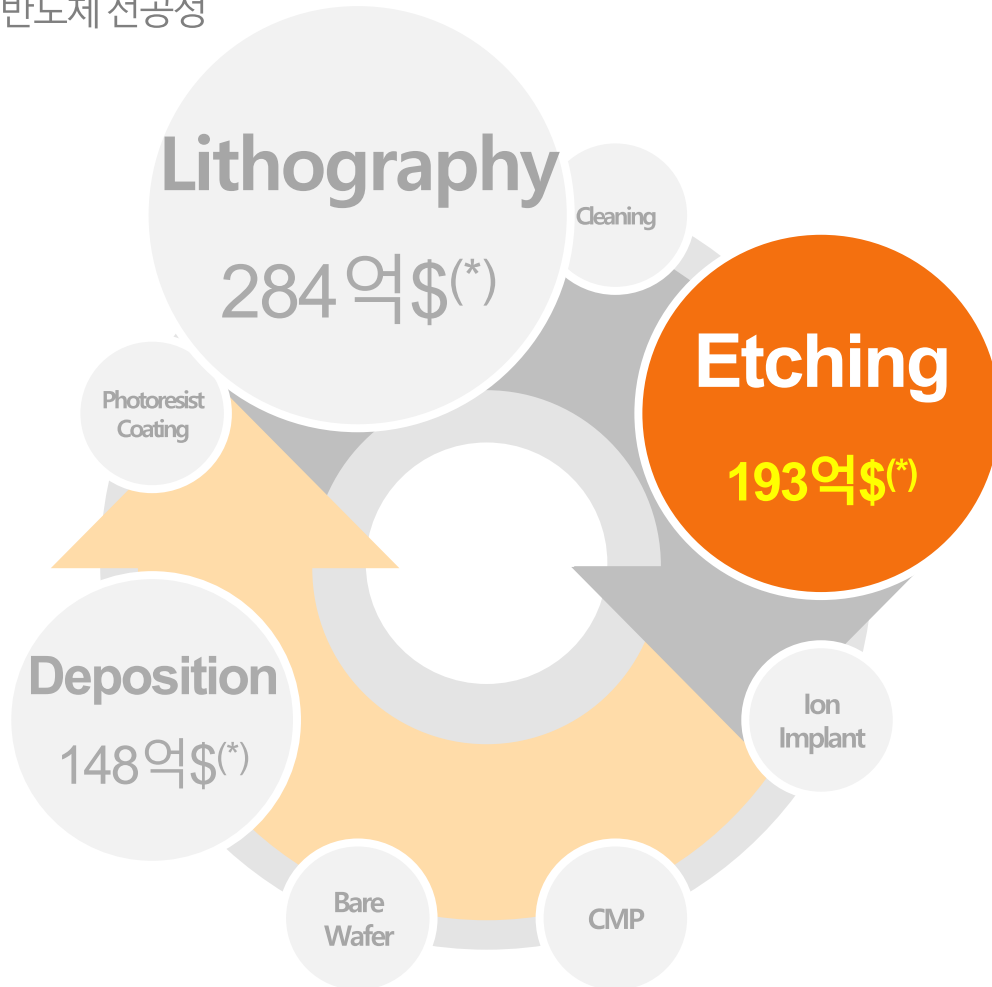
식각 (Etching) 공정이란?

노광 & 증착공정과 함께 **반도체의 3대 핵심 공정** (총 8공정) 중의 한 공정이며, **국내**의 글로벌 식각장비 기술 업체는 **VM**이 **유일**

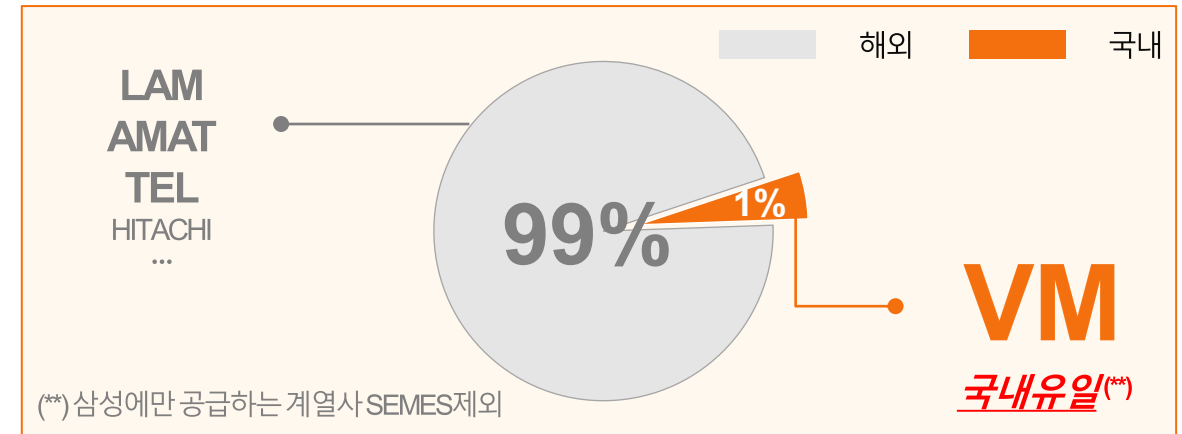


Gartner WFE
Capacity_3Q25

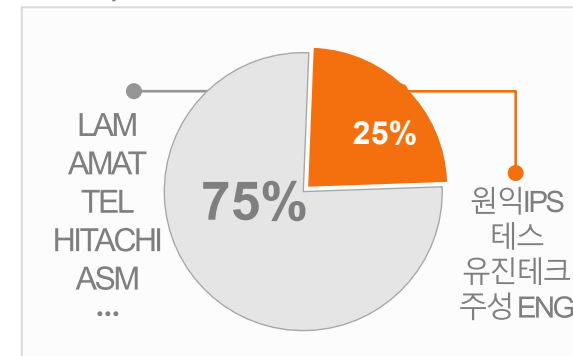
※반도체 전공정



※ Etching 장비 글로벌시장점유율






※ Deposition



※ Lithography_(EUV ARF 기준)



구 분	Model		Status	Device	Process	Features
Conductor ETCHER		Leo NK I-C	양산	DRAM	Non-critical Etch	High Productivity /High Process Reliability
				NAND		Low Defectivity
		Leo WH	양산	DRAM	Middle & High Critical Etch	Advantage for Total Cost Ownership
				NAND		High Productivity /High Process Reliability
		Leo WS	DEMO TEST	DRAM	High Critical Etch	Enhance yield of wafer-edge dies
				NAND		High Operation Rate
				H/W High Performance		
				Process High Reliability Repeatability		
					Wafer Productivity Quality Up	
Dielectric ETCHER		Nardo M	양산	DRAM	Critical / Non-critical Metal Etch	High Productivity /High Process Reliability
				NAND		Low Defectivity
						Advantage for Total Cost Ownership
OXIDE ETCHER		Mona LISA	Developing	DRAM	Non-critical Oxide Etch	High Productivity /High Process Reliability
				NAND		Low Defectivity
ALE		APES A	Developing	DRAM	High Critical Etch Complex-geometry Etch	Advantage for Total Cost Ownership
				NAND		High Productivity /High Process Reliability
					High Selectivity	
					Hybrid Etch (Thermal/Plasma)	

CONTENTS

VM Investor Relations 2025

01 회사소개

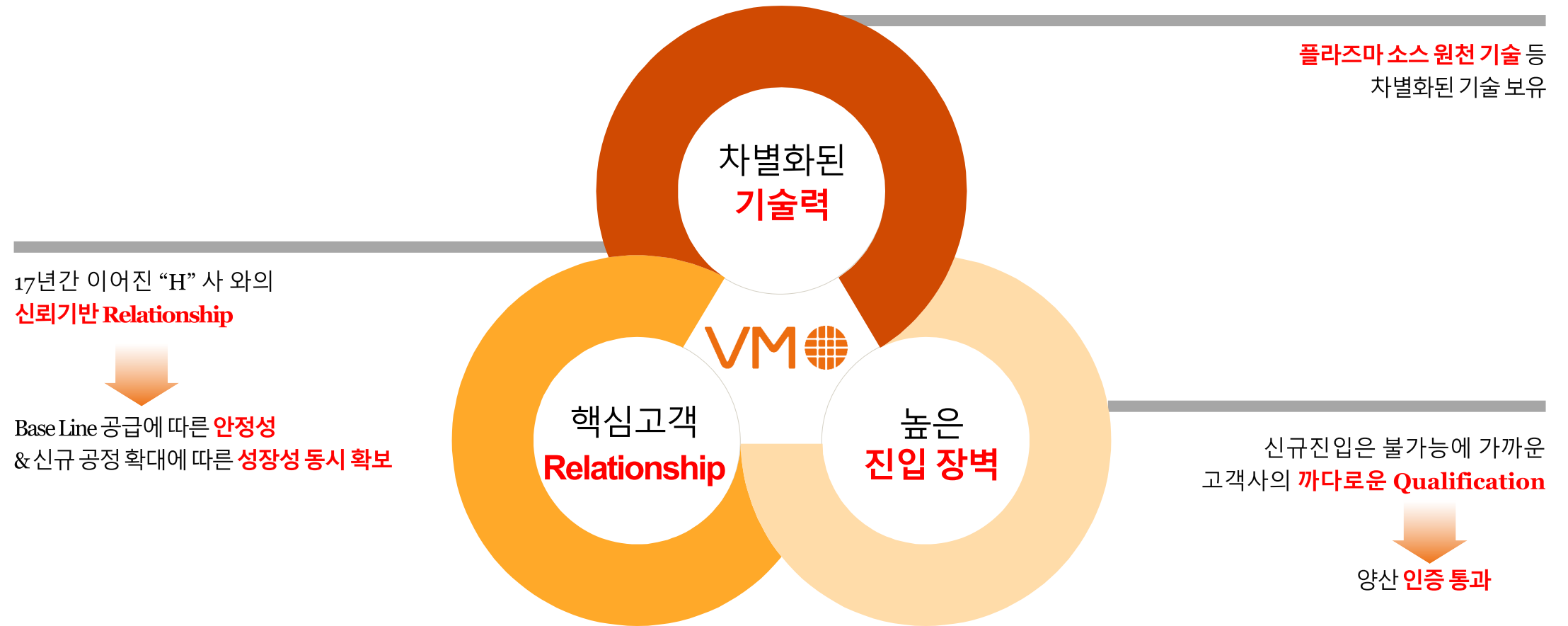
02 Our Business

03 Our Strength

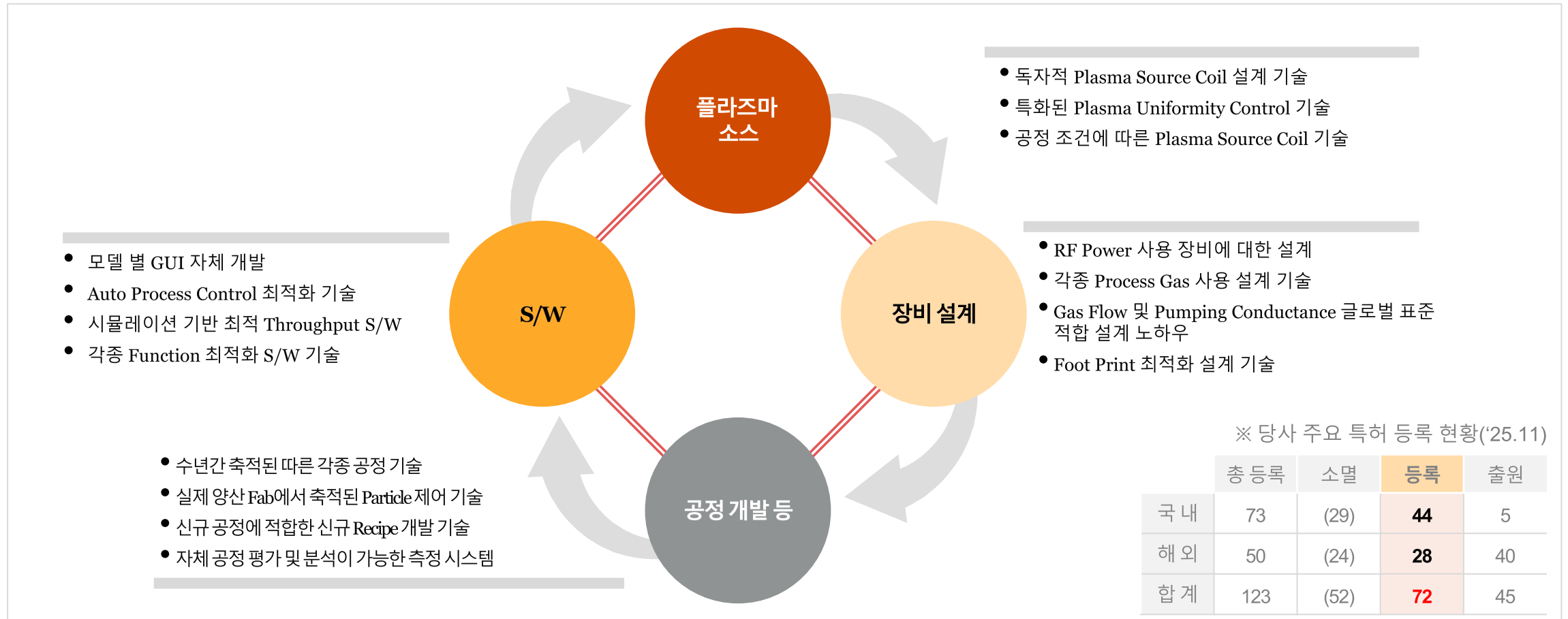
04 Our Status

05 Our Strategy

- Appendix



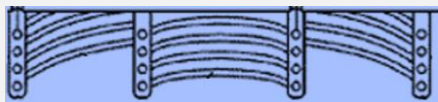
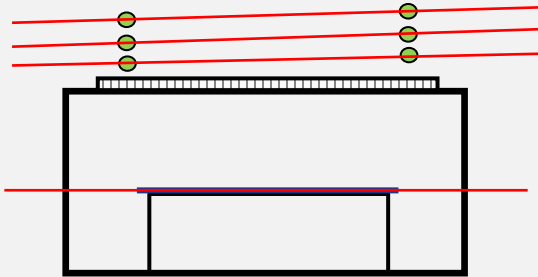
차별화된 **플라즈마 소스 원천 기술**을 통한 **글로벌 기술경쟁력** 보유



차별화된 기술력

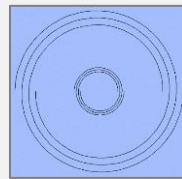
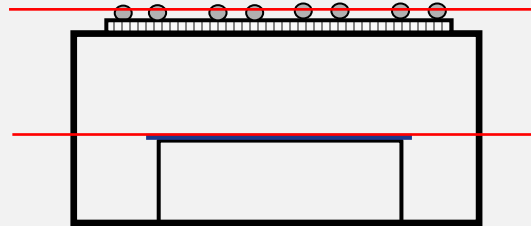
※ VM's 플라즈마 코일 vs 타사

A사



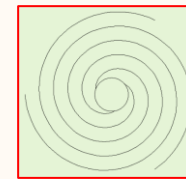
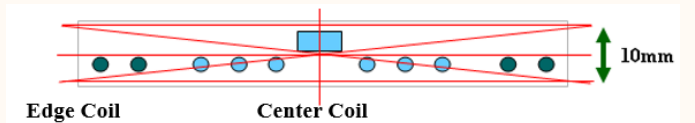
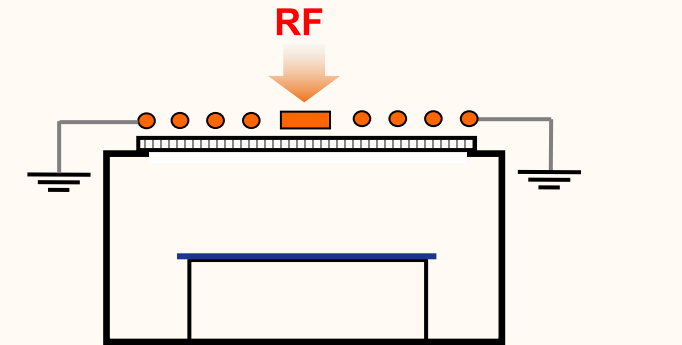
다수의 Coil Plane & 사선 구조라
Tilting Control이 직관적이지 못함
 효과가 없거나 미미할 것 예상됨

L사



Dome과 Coil이 붙어 있음
Tilting Mechanism 구현 불가

VM

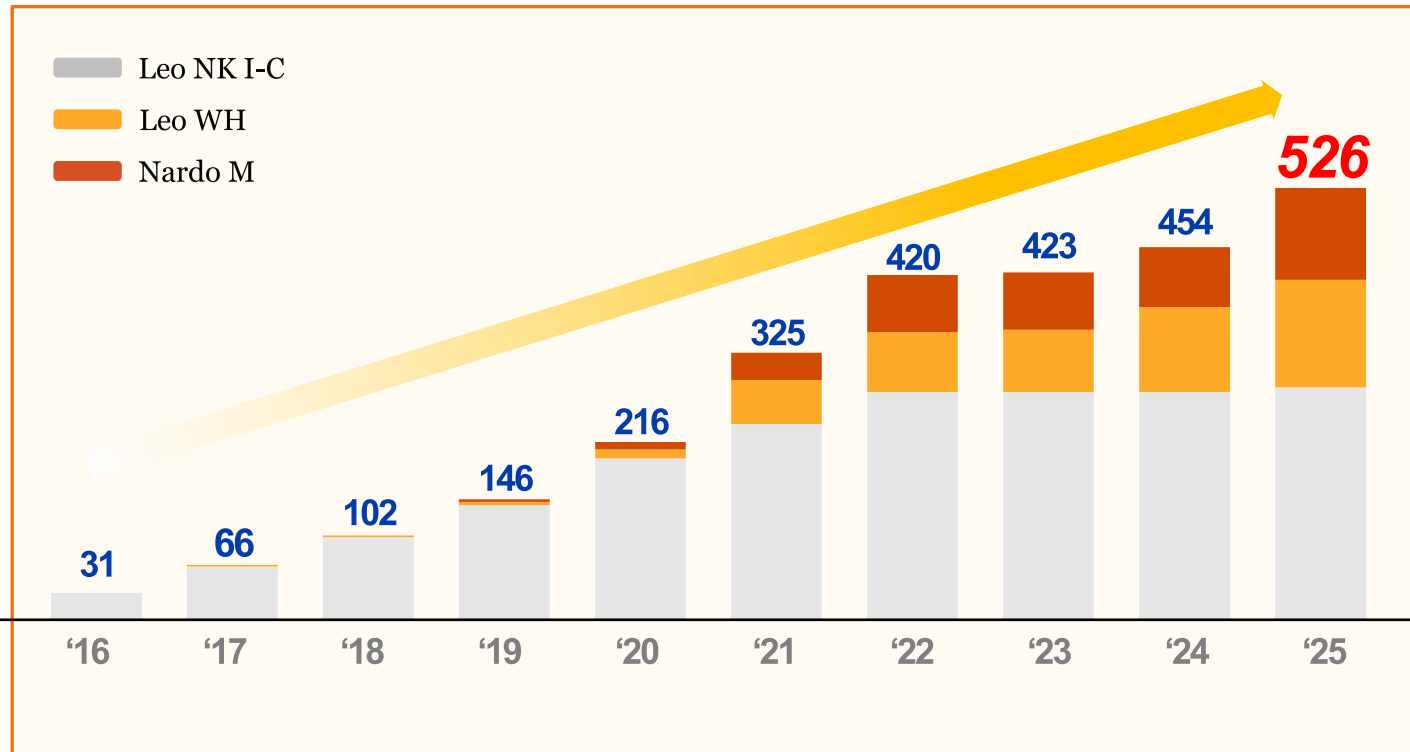


나선형 Symmetry 구조 **병렬 합성 Coil**
 Dome 사이 공간을 통해 **Tilting Mechanism** 구현
뚜렷한 Tilting 효과 및 **직관적 Control** 가능

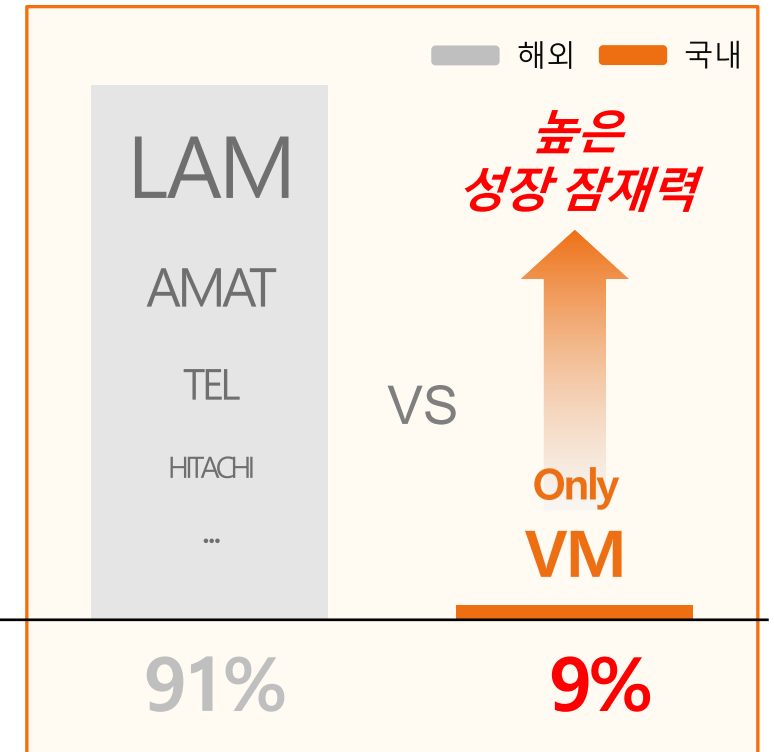
핵심고객 Relationship

신뢰기반 Relationship에 따른 **Base Line 공급 안정성** & 공정 점유율 확대에 따른 **높은 성장성** 동시 보유

※ “H” 사 누적 챔버 판매량



※ “H” 사 식각공정 점유율

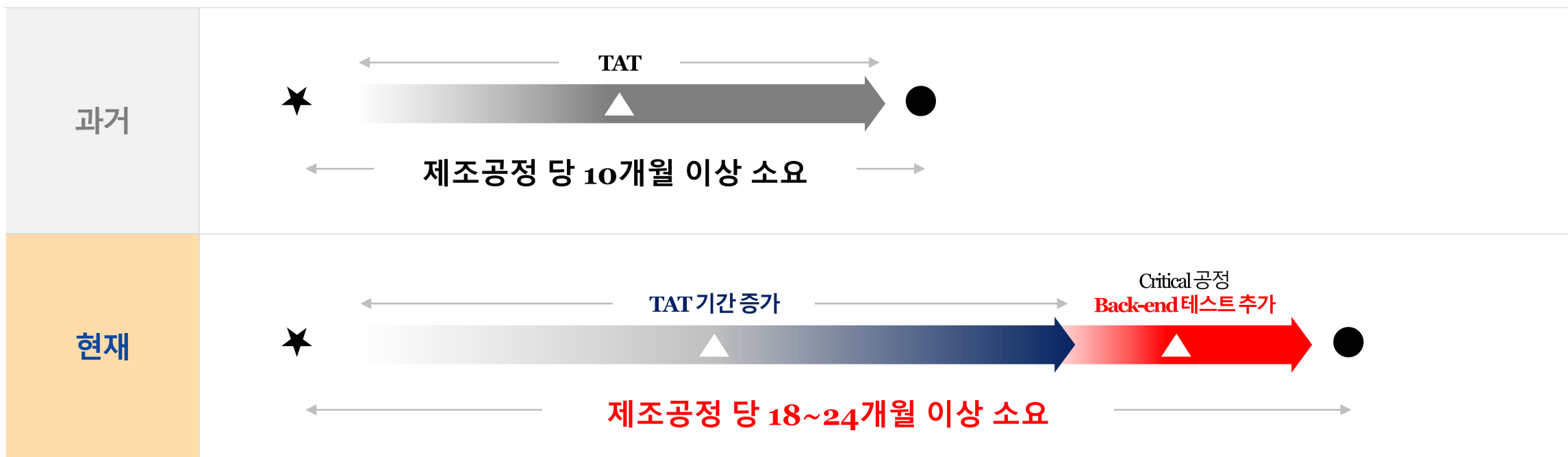


높은 진입장벽

공정의 **미세화** ▶ **점점 더 까다로운 Qualification** ▶ 기존 검증 업체 외 **신규업체 진입 거의 불가**

※ “H”사 Qualification 공정 TEST Process (예시)

★ 공정착수 ▲ 켈 테스트 ● TEST완료



(*)TAT : Turn Around Time, 웨이퍼가 모든 공정을 거쳐 최종적으로 반도체 칩이 되어 공장을 빠져나오는 데까지 걸리는 총 소요 시간

(*)Back-end Test: 완성된 반도체 칩이 정상적으로 작동하는지, 그리고 제품의 기능과 성능이 규격에 맞는지 여부에 대한 최종 검사


높은 진입장벽

고객사의 까다로운 **Qualification** 통과 성공 & 차세대 제품에 대한 **테스트 진행 중**

※주요 고객사 양산장비 투입 및 테스트 현황

“H”	Requirement	Our Position
	<ul style="list-style-type: none"> 타 공급사 대비 기술적 역량 & 비용 경쟁력 모두 충족 필요한 기능만을 반영한 Customized 장비 요구 	<ul style="list-style-type: none"> 다수 공정에서 Qualification 통과 & Base 장비 선정 차세대 제품 Customized 평가 진행 중

○ Leo WH ○ Leo WS ○ Nardo M

Front  End

CONTENTS

VM Investor Relations 2025

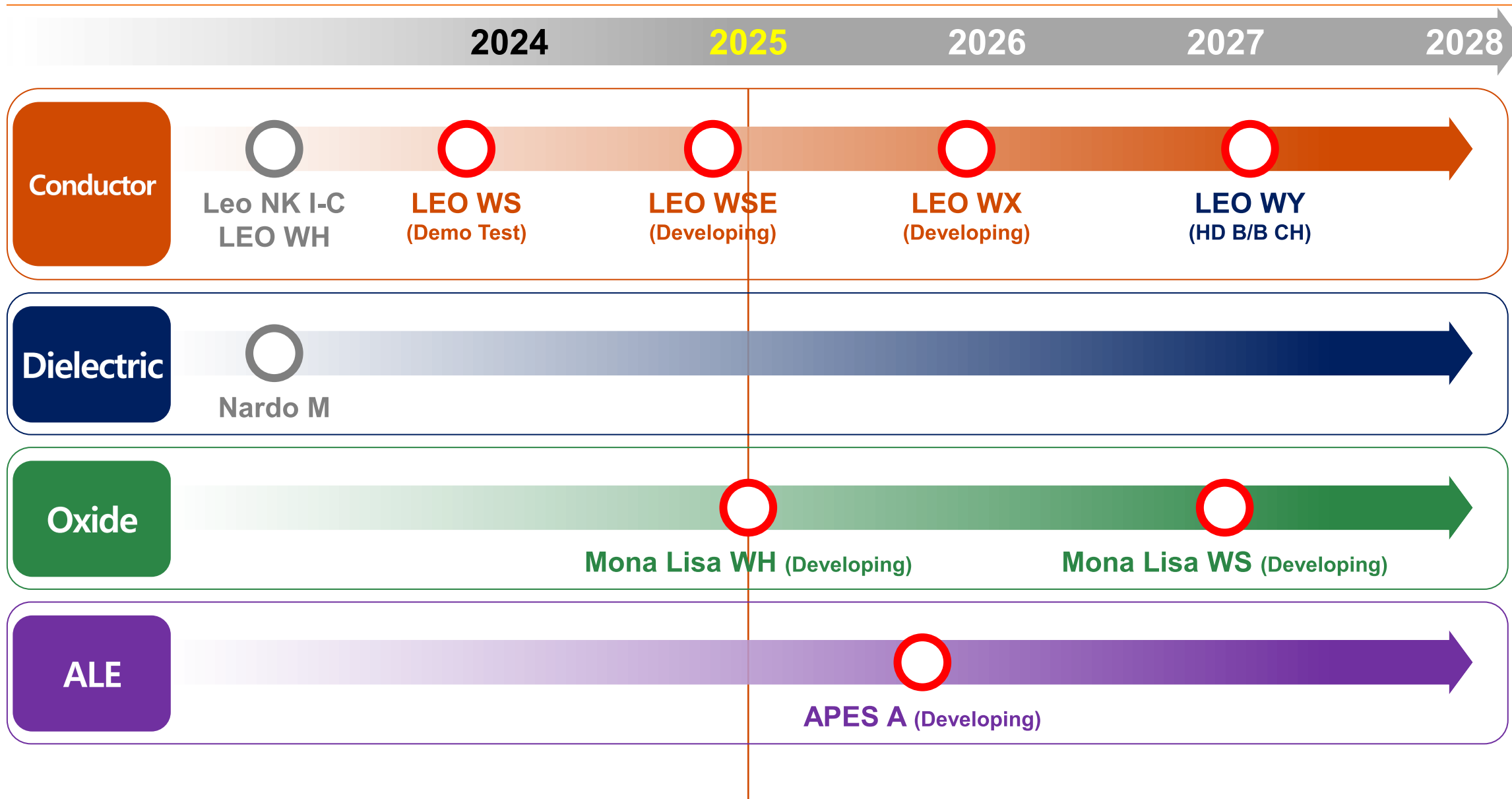
01 회사소개

02 Our Business

03 Our Strength

04 Our Strategy

- Appendix



공정확대 목표

신규공정 BASE 전환을 통한 공정 점유율 확대 계획

현재 (As-Is)

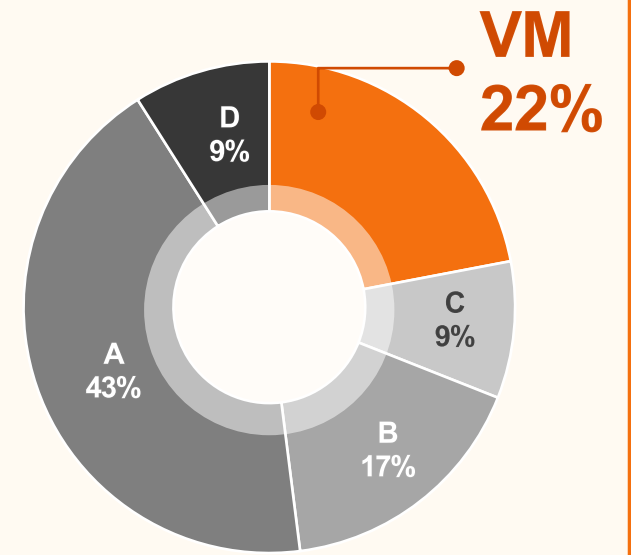
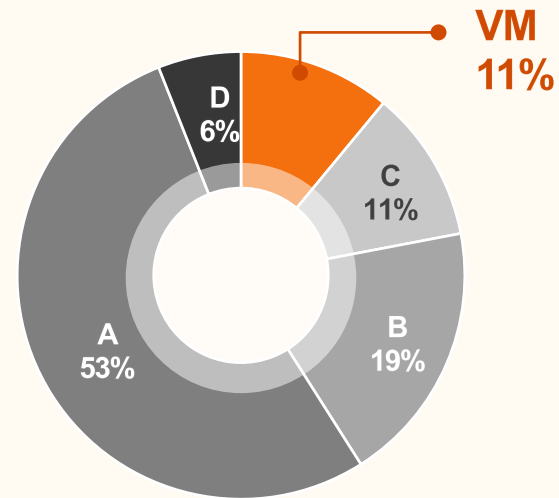
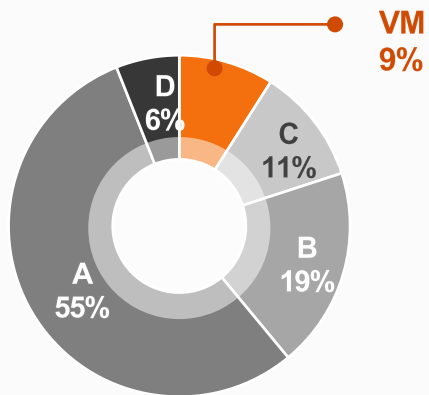
PHASE 1 ('26 ~ '27)

PHASE 2 ('27 ~ '28)

WH 신규공정 4개 Release 목표
WS 신규공정 1개 Release 목표
WX & Mona Lisa 평가완료 목표

WH 신규공정 2개 Release 목표
WX & Mona Lisa 평가개시

현 BASE 공정투자



글로벌 진출 Roadmap

“I” 사 Qualification 통과 및 이를 기반으로 한 해외 진출 적극 모색



Benefits with VM

Technical Support
& Process Optimization

기술 지원과 공정 개발
소 과정에 대한 긴밀한 협응
역량 보유



New alternative

글로벌 건식 식각시장의
새로운 대안(New Partner)

Lower TCO

타사 대비 TCO 절감을 통한
수익성 극대화

Our Goal

**" Global VM
within 2 Years "**

용인 반도체 클러스터 본사이전 조감도



소재지	용인 원삼면 반도체 클러스터
규모	토지 2,580평 건폐율 80%(2,064평) 용적률 350%(7,224평)
소요 예산	약 700억 전후
준공시기	‘28년 초 (예상)

CONTENTS

VM Investor Relations 2025

01 회사소개

02 Our Business

03 Our Strength

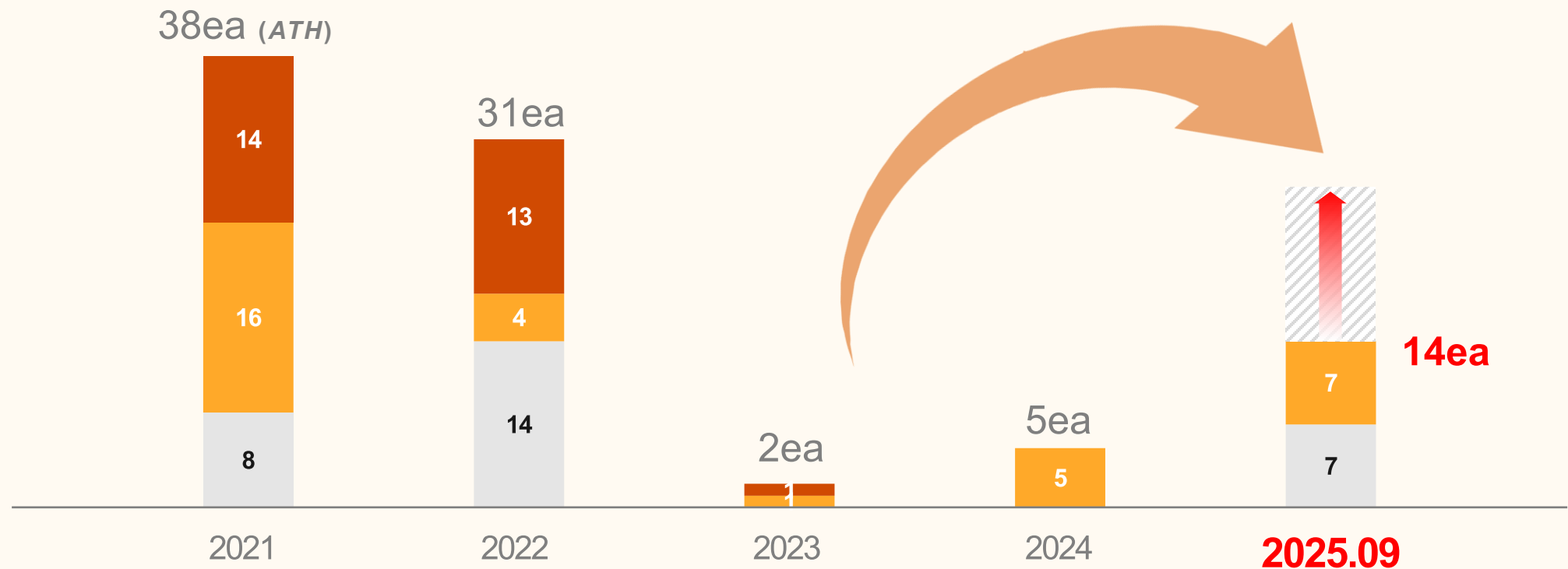
04 Our Strategy

- Appendix

제품 별 판매량

빠른 실적회복 & 26년 ATH(All Time High) 갱신 전망

WH NK NardoM



요약 재무제표

요약 재무상태표

(단위 : 억원, 연결재무제표)

구 분		2021	2022	2023	2024	2025.09
자산	유동자산	1,337	1,451	1,407	1,505	1,938
	비유동자산	119	115	102	152	190
부채	유동부채	283	373	270	393	485
	비유동부채	32	14	18	21	29
자본	자본금 등	204	179	291	349	570
	이익잉여금	937	1,000	930	894	1,044
부채자본비율		28%	33%	24%	33%	32%

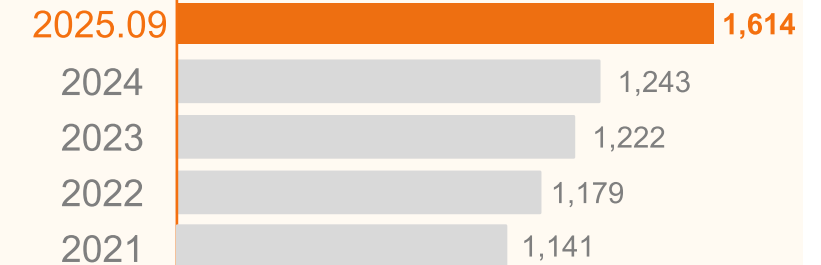
요약 손익계산서

(단위 : 억원, 연결재무제표)

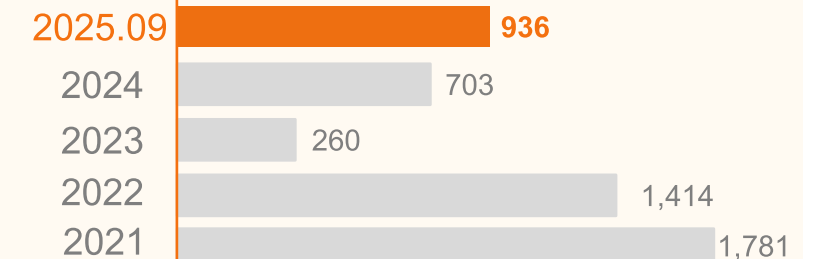
구 분		2021	2022	2023	2024	2025.09
매출액		1,781	1,414	260	703	936
매출총이익		774	595	127	234	352
영업이익		540	309	(110)	(86)	153
당기순이익		465	279	(70)	(35)	150
영업이익률		30.3%	21.9%	(42.2%)	(12.2%)	16.4%

(단위 : 억원, 연결재무제표)

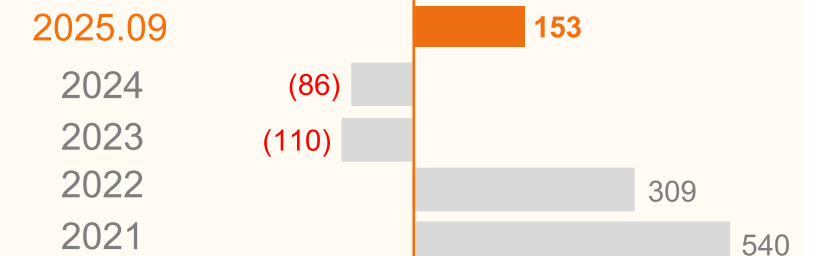
순자산



매출액



영업이익



	명칭	등록
1	고온 기체 공급형 공정 시스템	10-2826840
2	플라즈마 컨파이닝을 위한 플라즈마 처리 장치	10-2797766
3	기판 손상 감소 구조의 원자층 식각 장치	10-2691602
4	플라즈마 챔버의 상부 전극 체결용 수직 파스너 어셈블리	10-2689279
5	이종 소재 부품의 접착에 의한 모듈화 방법	10-2662900
6	상부 전극의 경사 및 위치 조절 시스템	10-2662977
7	분사 노즐 구조의 웨이퍼 잔존 가스 제거 장치	10-2634530
8	셀로우 에칭 프로세스 챔버	10-2626118
9	멀티 층 EFEM을 포함하는 기판 이송장치	10-2638655
10	층 이동이 가능한 기판 이송 장치	10-2638654

	명칭	등록
11	상하부 자기 부상 레일을 이용하는 기판 이송 장치	10-2041518
12	기판 이송장치	10-2090278
13	기판 이송장치	10-2027110
14	플라즈마 에칭 시스템	10-1839578
15	압력 측정 오차 방지를 위한 입자 트랩 장치	10-2005843
16	다중 가열 영역 구종의 정전 척	10-1776848
17	부품 정렬 장치 및 이에 의한 부품 정렬 방법	10-1787500
18	플라즈마 소스 코일 및 이의 조정 방법	10-1748252
19	플라즈마 소스코일 어셈블리 및 이에 의한 가열 방법	10-1614410
20	분리형 플라즈마 소스 코일 및 이의 제어 방법	10-1585945

VM 특허 현황_국내

	명칭	등록
21	교환 장치 및 이에 의한 부품의 교환 방법	10-2090278
22	히터 패턴을 내장한 웨이퍼 척 및 제조 방법	10-2027110
23	복수의 가스공급채널을 갖는 반도체 제조설비	10-1839578
24	분리형 웨이퍼 서셉터 및 반도체 공정 챔버 장비	10-2005843
25	원자층 식각장비 및 이를 이용한 원자층 식각 방법	10-1776848
26	반도체 제조설비 및 반도체 웨이퍼 처리 방법	10-1787500
27	리프트핀을 갖는 반도체 제조설비 및 조립방법	10-1748252
28	높은 선택비를 갖는 식각방법 및 패턴 형성방법	10-1614410
29	플라즈마를 이용한 반도체소자 식각장치 및 반도체 소자 식각방법	10-1585945
30	리모트 플라즈마 발생기 및 이를 이용한 반도체 제조장치	10-1567696

	명칭	등록
31	반도체 제조장치 및 이를 이용한 반도체소자 제조방법	10-1541392
32	반도체소자의 식각방법	10-1251072
33	새도우마스크를 갖는 플라즈마 도핑장치 및 도핑방법	10-1251073
34	균일한 플라즈마 밀도를 위한 플라즈마 소스 및 챔버	10-1308687
35	반도체 제조용 챔버의 웨이퍼 고정장치 및 방법	10-1157587
36	플라즈마 도핑 장치 및 방법	10-1098794
37	반도체소자 제조를 위한 프로세스 챔버의 운영방법	10-1075127
38	대구경 웨이퍼 처리 적응형 플라즈마 소스 & 챔버	10-1098793
39	적응형 플라즈마 소스를 갖는 플라즈마 반응챔버	10-1063319
40	적응형 플라즈마 소스 및 적응형 플라즈마 챔버	10-0844027

VM 특허 현황_국내

	명칭	등록
41	플라즈마 식각방법	10-0844029
42	가스 공급 인젝터를 포함하는 플라즈마 공정 장비	0748872(20
43	정전척을 포함하는 플라즈마 공정장비	0788956(20
44	헬륨 공급부를 포함하는 정전척 장치	10-0816526

VM 특허 현황_해외

	명칭	등록	등록국가
1	SPRAYING NOZZLE TYPE OF AN APPARATUS FOR REMOVING A RESIDUAL GAS ON A WAFER	I865270	대만
2	SUBSTRATE TRANSFER APPARATUS	I888130	대만
3	SUBSTRATE TRANSFER APPARATUS INCLUDING MULTI-LAYER EFEM	I889064	대만
4	SUBSTRATE TRANSFER APPARATUS ALLOWING MOVEMENT BETWEEN LAYERS	I889063	대만
5	SUBSTRATE TRANSFER APPARATUS USING UPPER AND LOWER MAGNETIC LEVITATION RAILS	I863747	대만
6	상부 전극의 경사 및 위치 조절 시스템	7621002	일본
7	셀로우 에칭 프로세스 챔버	7607367	일본
8	SUBSTRATE TRANSFER APPARATUS USING UPPER AND LOWER MAGNETIC LEVITATION RAILS	7649569	일본

	명칭	등록	등록국가
9	SYSTEM FOR ETCHING WITH A PLASMA	I836422	대만
10	SYSTEM FOR ETCHING WITH A PLASMA	7328720	일본
11	PARTICLE TRAPPING APPARATUS FOR PREVENTING AN ERROR OF A PRESSURE MEASUREMENT	I853228	대만
12	PARTICLE TRAPPING APPARATUS FOR PREVENTING AN ERROR OF A PRESSURE MEASUREMENT	US 11,841,284 B2	미국
13	PARTICLE TRAPPING APPARATUS FOR PREVENTING AN ERROR OF A PRESSURE MEASUREMENT	7450954	일본
14	An Electrostatic Chuck with Multi Heating Area	I796780	대만
15	ELECTROSTATIC CHUCK WITH MULTIPLE HEATER ZONES	7213592	일본
16	APPARATUS FOR MONITORING AN EXCHANGING PROCESS OF A SEMICONDUCTOR COMPONENT AND A METHOD FOR THE SAME	US 11,538,702 B2	미국

VM 특허 현황_해외

	명칭	등록	등록국가
17	APPARATUS FOR MONITORING AN EXCHANGING AN ARTICLE OF A SEMI-CONDUCTOR PROCESS AND A METHOD FOR EXCHANGING THE ARTICLE USING THE SAME	7153362	일본
18	APPARATUS FOR MONITORING AN EXCHANGING PROCESS OF A SEMICONDUCTOR COMPONENT AND A METHOD FOR THE SAME	1759960	대만
19	STRUCTURE VARIABLE TYPE OF A PLASMA SOURCE COIL AND A METHOD FOR CONTROLLING THE SAME	11315764	미국
20	STRUCTURE VARIABLE TYPE OF A PLASMA SOURCE COIL AND A METHOD FOR CONTROLLING THE SAME	6955791	일본
21	APPARATUS FOR MONITORING AN EXCHANGING PROCESS OF A SEMICONDUCTOR COMPONENT AND A METHOD FOR THE SAME	6989980	일본
22	STRUCTURE VARIABLE TYPE OF A PLASMA SOURCE COIL AND A METHOD FOR CONTROLLING THE SAME	CN 113782409 B	중국
23	An Apparatus for Arranging an Article of a Semi Conduct Process and a Method for Arranging the Article with the Same	CN 113782410 B	중국
24	SEPARATE PLASMA SOURCE COIL AND METHOD OF CONTROLLING THE SAME	CN 112242288 B	중국

	명칭	등록	등록국가
25	SEPARATE PLASMA SOURCE COIL AND METHOD OF CONTROLLING THE SAME	10825655	미국
26	SUBSTRATE TRANSFER APPARATUS	7729643	일본
27	SUBSTRATE TRANSFER APPARATUS INCLUDING MULTI-LAYER EFEM	7736325	일본
28	PLASMA PROCESSING DEVICE INCLUDING BAFFLE FOR PLASMA CONFINING	7763531	일본

감사합니다.